# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.3.4

# Эффект Холла в полупроводниках

выполнил студент 006 группы ФЭФМ Штрайх Роберт **Цель работы:** измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

**В работе используются:** электромагнит с регулируемым источником питания; вольтметр; амперметр; миллиамперметр; милливеберметр или миллитесламетр; источник питания (1,5 В), образцы легированного германия.

#### 1 Теоретические сведения

Во внешнем магнитном поле B на заряды действует сила Лоренца:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B}.\tag{1}$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с E. Возникновение поперечного тока электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют эффектом Xолла.

В работе изучаются особенности проводимости проводников в геометрии мостика Холла. Ток пропускается по плоской полупроводниковой пластинке, помещённой в перпендикулярное пластинке магнитное поле. Измеряется разность потенциалов между краями пластинки в поперечном к току направлении. По измерениям определяется константа Холла, тип проводимости (электронный или дырочный) и на основе соотношения (3) вычисляется концентрация основных носителей заряда.

### 2 Расчётные формулы

• ЭДС Холла:

$$\mathscr{E}_{\mathbf{x}} = U_{34} - U_0, \tag{2}$$

• Постоянная Холла:

$$R_x = -\frac{\mathscr{E}_{\mathbf{x}}}{B} \cdot \frac{a}{I} = \frac{1}{nq},\tag{3}$$

• Концентрация носителей тока в образце:

$$n = \frac{1}{R_x e},\tag{4}$$

• Удельная проводимость материала образца:

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al},\tag{5}$$

• Подвижность носителей тока:

$$b = \frac{\sigma}{en}. (6)$$

## 3 Экспериментальная установка

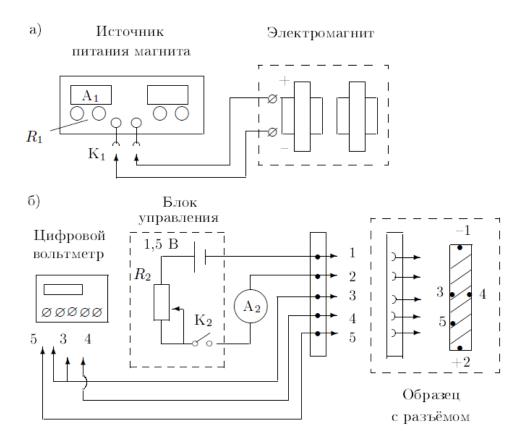


Рис. 1: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках